

Repasso de las expresiones de Av, Ri y Ro de las distintas configuraciones con transistores bipolares y unipolares.

Transistores bipolares.

Configuración emisor común con Re desacoplada (EC).

$$|Av| = \frac{Vo}{Vi} = \frac{Vce}{Vbe} = \frac{ic.(ro//Rd)}{ib.hie} = \frac{hfe.(ro//Rd)}{hie} \quad ro=1/hoe \quad hfe/hie=gm$$

$$|Av| = \frac{Vce}{Vbe} = gm.(ro//Rd) \quad si \quad ro \geq 10 Rd$$

$$|Av| = \frac{Vce}{Vbe} = gm.Rd = f(ICQ ; Rd)$$

Expresiones de Ri y Ro:

$$Ri=hie=hfe/gm \rightarrow hie=hfe/40.I_{CQ}(mA/V) \quad Si \quad I_{CQ} \uparrow \rightarrow gm \uparrow \rightarrow Ri=hie \downarrow$$

$$ro=1/hoe \rightarrow hoe=\eta.gm=3.10^4.40.I_{CQ}(mA/V) \quad Si \quad I_{CQ} \uparrow \rightarrow gm \uparrow \rightarrow hoe \uparrow \rightarrow ro \downarrow$$

$$Ri = hie = mediana = algunos k\Omega para I_{CQ} = algunos mA$$

$$ro = 1/hoe = medianamente alta > 10k\Omega a decenas de k\Omega para I_{CQ} = algunos mA$$

Configuración emisor común con Re sin desacoplar.

$$|Av| = \frac{Vo}{Vi} = \frac{Vc}{Vb} = \frac{ic.(Ro//Rd)}{ib.Ri} = \frac{hfe.(Ro//Rd)}{hie.(1+gm.RE)}$$

$$Si \quad Ro \geq 10Rd \rightarrow |Av| = \frac{Vc}{Vb} = \frac{hfe.Rd}{hie.(1+gm.RE)} \quad hfe/hie=gm$$

$$|Av| = \frac{Vc}{Vb} = \frac{gm.Rd}{1+gm.RE}$$

$$Si \quad gm.RE \geq 10 \rightarrow |Av| = \frac{Vc}{Vb} \approx \frac{gm.Rd}{gm.RE} \approx \frac{Rd}{RE} \neq f(ICQ)$$

Expresiones de Ri y Ro:

$$Ri = hie.(1+gm.RE)$$

$$Ro = ro.(1 + \frac{hfe.RE}{RE+hie+Rth}) \quad ro=1/hoe \quad Rth=Rg//RB$$

$$\text{Si } hie \geq 10.(RE+Rth) \rightarrow Ro = ro \cdot \left(1 + \frac{hfe}{hie} \cdot RE\right)$$

$$Ro = ro \cdot (1 + gm \cdot RE)$$

Si $RE \uparrow$ o $gm \uparrow \rightarrow Ri$ y Ro aumentan

$Ri = \text{alta} = \text{decenas a centenas de k}\Omega$ para $I_{CQ} = \text{algunos mA}$

$ro = \text{muy alta} = \text{centenas de k}\Omega$ a $M\Omega$ para $I_{CQ} = \text{algunos mA}$

Configuración base común (BC).

$$Av = \frac{Vo}{Vi} = \frac{Vcb}{Veb} = \frac{ic \cdot (ro//Rd)}{ib \cdot hie} = \frac{hfe \cdot \left(\frac{1}{hob}\right) // Rd}{hie}$$

Como $ro = 1/hob = [M\Omega] \gg Rd \quad hfe/hie = gm$

$$Av = \frac{Vcb}{Veb} = gm \cdot Rd = f(I_{CQ}; Rd)$$

Expresiones de Ri y Ro :

$$Ri = hie/(1+hfe) = hib = 1/gm \rightarrow Ri_{BC} = Ri_{EC} / (1+hfe)$$

$gm = 40 \cdot I_{CQ} (\text{mA/V}) \quad \text{Si } I_{CQ} \uparrow \text{ o } hfe \uparrow \rightarrow Ri = hib \downarrow$

$$ro = \frac{1}{hoe} (1+hfe) = 1/hob \rightarrow ro_{BC} = ro_{EC} \cdot (1+hfe) \quad \text{Si } hfe \uparrow \rightarrow ro \uparrow$$

$Ri = hib = \text{baja} = \text{algunos }\Omega$ para $I_{CQ} = \text{algunos mA}$

$ro = 1/hob = \text{muy alta, del orden de algunos M}\Omega$ para $I_{CQ} = \text{algunos mA}$

Configuración colector común (CC).

$$Av = \frac{Vo}{Vi} = \frac{Vec}{Vbc} = \frac{ie \cdot Rd}{ib \cdot Ri} = \frac{ie \cdot Rd}{ib \cdot (hie \cdot (1+gm \cdot Rd))} \quad ie/ib = 1+hfe$$

$$Av = \frac{Vec}{Vbc} = \frac{(1+hfe) \cdot Rd}{hie \cdot (1+gm \cdot Rd)} \quad hfe/hie = gm$$

$$Av = \frac{Vec}{Vbc} = \frac{gm \cdot Rd}{1+gm \cdot Rd} \leq 1 \rightarrow \text{Si } gm \cdot Rd \geq 10 \rightarrow Av \approx 1$$

Expresiones de Ri y Ro:

$$R_i = h_{ie} \cdot (1 + g_m \cdot R_d) \rightarrow \text{Si } R_d \uparrow \text{ o } h_{fe} \uparrow \rightarrow R_i \uparrow$$

$$R_o = \frac{(R_g // R_B) + h_{ie}}{1 + h_{fe}} \approx \frac{h_{ie}}{1 + h_{fe}} = 1/g_m \rightarrow R_{oCC} \approx R_{iBC}$$

$R_i = \text{decenas a cientos de k}\Omega$ para $I_{CQ} = \text{algunos mA}$

$R_o \approx h_{ib} = 1/g_m = \text{baja} = \text{algunos }\Omega$ para $I_{CQ} = \text{algunos mA}$

Transistores unipolares.Configuración fuente común con R_s desacoplada (SC).

$$|A_v| = \frac{V_o}{V_i} = \frac{V_{ds}}{V_{gs}} = \frac{i_d \cdot (r_o // R_d)}{v_{gs}} = \frac{g_m \cdot v_{gs} (r_{ds} // R_d)}{v_{gs}}$$

$$|A_v| = \frac{V_{ds}}{V_{gs}} = g_m \cdot (r_{ds} // R_d)$$

$$\text{Si } r_{ds} \geq 10 \cdot R_d \rightarrow |A_v| = \frac{V_{ds}}{V_{gs}} = g_m \cdot R_d = f(Q; TR; R_d)$$

Expresiones de Ri y Ro:

$$R_i \rightarrow \infty \quad r_o = r_{ds} = \text{medianamente alta} > 10k\Omega \text{ a decenas de k}\Omega$$

Configuración fuente común con R_s sin desacoplar.

$$|A_v| = \frac{V_o}{V_i} = \frac{V_d}{V_g} = \frac{i_d \cdot (R_o // R_d)}{v_g} \quad R_o \approx r_{ds} \cdot (1 + g_m \cdot R_s) \quad i_d = g_m \cdot v_{gs}$$

$$\text{Si } R_o \geq 10 \cdot R_d \rightarrow |A_v| = \frac{V_d}{V_g} = \frac{i_d \cdot R_d}{v_g} = \frac{g_m \cdot v_{gs} \cdot R_d}{v_g}$$

$$v_{gs} = v_g - v_s = v_g - i_d \cdot R_s = v_g - g_m \cdot v_{gs} \cdot R_s$$

$$v_g = v_{gs} + g_m \cdot v_{gs} \cdot R_s \rightarrow v_g = v_{gs} (1 + g_m \cdot R_s)$$

$$|Av| = \frac{Vd}{Vg} = \frac{gm.vgs.Rd}{vgs(1+gm.Rs)} = \frac{gm.Rd}{1+gm.Rs}$$

$$\text{Si } gm.Rs \geq 10 \rightarrow |Av| = \frac{Vd}{Vg} \approx \frac{gm.Rd}{gm.Rs} \approx \frac{Rd}{Rs} \neq f(Q; TR)$$

Expresiones de Ri y Ro:

$$Ri = \infty \cdot (1+gm.Rs) = \infty \quad Ro \approx rds \cdot (1+gm.Rs) = \text{alta} > rds$$

Configuración compuerta común (GC).

$$Av = \frac{Vo}{Vi} = \frac{Vdg}{Vsg} = \frac{id.(Ro//Rd)}{vsg} \quad Ro \approx rds \cdot (1+gm.(Rs//Rg))$$

$$\text{Si } Ro \geq 10.Rd \rightarrow Av = \frac{Vdg}{Vsg} = \frac{id.Rd}{vsg} = \frac{gm.vsg.Rd}{vsg} = gm.Rd = f(Q; TR; Rd)$$

Expresiones de Ri y Ro:

$$Ri = 1/gm = \text{cientos de } \Omega \quad Ro \approx rds \cdot (1+gm.(Rs//Rg)) = \text{alta} > rds$$

Configuración drenador común (DC).

$$Av = \frac{Vo}{Vi} = \frac{Vsd}{Vgd} = \frac{is.(Ro//Rd)}{vgd} \quad is = id = gm.vgd \quad Ro = (1/gm)//rds \approx 1/gm$$

$$Av = \frac{Vsd}{Vgd} = \frac{gm.vgd \cdot ((1/gm)//Rd)}{vgd} = gm \cdot ((1/gm)//Rd)$$

$$Av = \frac{Vsd}{Vgd} = \frac{Rd}{Rd+1/gm} = \frac{gm.Rd}{1+gm.Rd} \leq 1$$

$$\text{Si } gm.Rd \gg 1 \rightarrow Av \approx 1 \neq f(Q; TR; Rd)$$

Expresiones de Ri y Ro:

$$Ri \rightarrow \infty \quad Ro = (1/gm)//rds \approx 1/gm = \text{cientos de } \Omega$$

Resumen de fórmulas de R_i , R_o y A_v de las distintas configuraciones con transistores bipolares y unipolares.

Transistores bipolares.

Emisor común con R_E desacoplada:

$$R_i = h_{ie} = h_{fe}/gm$$

$$r_o = 1/h_{oe} \rightarrow h_{oe} = \eta \cdot gm$$

$$|A_v| = \frac{V_{ce}}{V_{be}} = gm \cdot R_d$$

Emisor común con R_E sin desacoplar:

$$R_i = h_{ie} \cdot (1 + gm \cdot R_E)$$

$$R_o = r_o \cdot (1 + gm \cdot R_E) \quad r_o = 1/h_{oe}$$

$$|A_v| = \frac{V_c}{V_b} = \frac{gm \cdot R_d}{1 + gm \cdot R_E}$$

Base común:

$$R_i = h_{ie} / (1 + h_{fe}) = h_{ib} = 1/gm$$

$$r_o = \frac{1}{h_{oe}} (1 + h_{fe}) = 1/h_{ob}$$

$$A_v = \frac{V_{cb}}{V_{eb}} = gm \cdot R_d$$

Colector común:

$$R_i = h_{ie} \cdot (1 + gm \cdot R_d)$$

$$R_o \approx \frac{h_{ie}}{1 + h_{fe}} = 1/gm$$

$$A_v = \frac{V_{ec}}{V_{bc}} = \frac{gm \cdot R_d}{1 + gm \cdot R_d} \leq 1$$

Luego para todos los casos:

$$A_{vs} = A_v \frac{R_{ia}}{R_{is}}$$

Transistores unipolares.

Fuente común con R_s desacoplada:

$$R_i \rightarrow \infty$$

$$r_o = r_{ds}$$

$$|A_v| = \frac{V_{ds}}{V_{gs}} = gm \cdot R_d$$

Fuente común con R_s sin desacoplar:

$$R_i = \infty \cdot (1 + gm \cdot R_s) = \infty$$

$$R_o \approx r_{ds} \cdot (1 + gm \cdot R_s)$$

$$|A_v| = \frac{V_d}{V_g} = \frac{gm \cdot R_d}{1 + gm \cdot R_s}$$

Compuerta común:

$$R_i = 1/gm$$

$$R_o = r_{ds} \cdot (1 + gm \cdot (R_s // R_g))$$

$$A_v = \frac{V_{dg}}{V_{sg}} = gm \cdot R_d$$

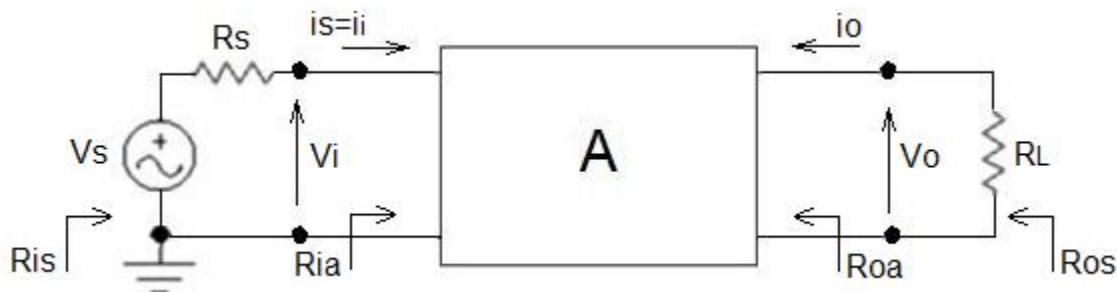
Drenador común:

$$R_i \rightarrow \infty$$

$$R_o = (1/gm) // r_{ds} \approx 1/gm$$

$$A_v = \frac{V_{sd}}{V_{gd}} = \frac{gm \cdot R_d}{1 + gm \cdot R_d} \leq 1$$

Distintos amplificadores básicos con sus R_i y R_o característicos.



Vinculando las distintas variables de salida y entrada del cuadripolo, obtenemos las 4 transferencias o ganancias posibles:

$$A = V_o/V_i = Av = \text{amplif. de tensión} = (\text{veces}) \quad R_i \rightarrow \infty \quad R_o \rightarrow 0$$

$$A = I_o/I_i = A_i = \text{amplif. de corriente} = (\text{veces}) \quad R_i \rightarrow 0 \quad R_o \rightarrow \infty$$

$$A = V_o/I_i = R_m = \text{amplif. de transresistencia} = (V/mA) \quad R_i \rightarrow 0 \quad R_o \rightarrow 0$$

$$A = I_o/V_i = G_m = \text{amplif. de transconductancia} = (mA/V) \quad R_i \rightarrow \infty \quad R_o \rightarrow \infty$$

Calculando $A_{vs} = v_o/v_s$, podemos obtener las demás transferencias en función de A_{vs} , como se indica a continuación:

$$A_{is} = \frac{i_o}{i_s} = \frac{v_o/R_L}{v_s/R_{is}} = \frac{v_o}{v_s} \frac{R_{is}}{R_L} = A_{vs} \frac{R_{is}}{R_L}$$

$$R_{ms} = \frac{v_o}{i_s} = \frac{v_o}{v_s/R_{is}} = \frac{v_o}{v_s} R_{is} = A_{vs} \cdot R_{is}$$

$$G_{ms} = \frac{i_o}{v_s} = \frac{v_o/R_L}{v_s} = \frac{v_o}{v_s} \frac{1}{R_L} = A_{vs} \cdot \frac{1}{R_L}$$